



## 第十四届全国MOCVD学术会议

尊敬的\_\_\_\_\_先生/女士，您好！

第十四届全国MOCVD学术会议将于2016年08月在延边朝鲜族自治州召开。

### 会议通知

金属有机化学气相淀积（MOCVD）技术自二十世纪六十年代提出以来，取得了飞速进步，目前已经在氮化物、砷化物、磷化物、碲化物和氧化物等重要半导体材料及其量子结构的制备上得到广泛应用，极大地推动了光电子器件和电子器件的发展和产业化，也成为半导体超晶格、量子阱、量子线、量子点结构材料与器件研究的关键技术。未来MOCVD技术的发展将会给化合物半导体科学技术和产业发展带来更为广阔的前景。

作为MOCVD生长技术和化合物半导体材料器件研发交流的平台，自1989年第一届会议举办以来，“全国MOCVD学术会议”已经成功举办了十三届，规模和影响越来越大，已成为全国学术界和产业界广泛关注的学术盛会。本次会议选择在具有朝鲜族民族特色的边疆开放城市，素有“歌舞之乡”美称的延吉市举行，来自大陆和台港地区的与会学者、工程师和企业家将在MOCVD生长技术、MOCVD设备研发、材料结构与物性、以及光电子、电力电子器件、微波射频器件研发等领域开展广泛交流，了解发展动态，促进相互合作。这次会议必将对我国MOCVD学术研究、技术进步和第三代半导体产业发展起到有力的推动作用。

### 会议日程

会议主要日程：

- 8月16日下午 报到
- 8月17日上午 开幕式和大会报告
- 8月17日下午-18日上午 分会报告和交流
- 8月18日下午 大会报告和闭幕式
- 8月19日 参观考察

### 会议门票

会议注册费：

一般代表：2000元（包含会议文集和日程等会议资料、会议期间其它相关服务）

学生代表：1500元（与一般代表相同会议待遇，但须提交相关证件）

2016年6月30日前注册交费优惠：一般代表1800元，学生代表1300元

